(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

(19)日本国特許庁 (JP)

# 特開平10-45467

(43)公開日 平成10年(1998)2月17日

(51) Int. Cl. 6	故別 記号	庁 内 整 理 番 号	F I	技術表示箇所
CO4B 35/44			CO4B 35/44	
B01J 19/02			B01J 19/02	
C04B 35/00		•	C23F 4/00	A
C23F 4/00	0.0	·	HOIL 21/205	
HO1L 21/205			C23C 16/50	
	, ,	卷 査 請 求	未請求 請求項の数1	OL (全4頁) 最終頁に続く
(0.1) (1) 865 77. 52	4+ 655 TT 0 0 0 1		(71)出顧人 0000	0 6 6 2 2
(21)出願番号	特願平8-201		京セラ株	0 6 6 3 3 式会社
(22)出顧日	平成8年(199	6) 7月31日 ·	京都府京	郡市山科区東野北井ノ上町 5 番地
		•	o 2 2	
	,	•	(72)発明者 伊東 裕县	見子
•	• 1	•	鹿児島県[	国分市山下町1番4号゛ 京セラ株
			式会社総合	合研究所内
		•	(72)発明者 会田 比	<b>写</b> 史
	*1		鹿児島県 [	国分市山下町1番4号 京セラ株
•	•		式会社総1	合研究所内
		•	·	
			•	
				,
	•			

### (54) 【発明の名称】耐食性部材

# (57)【要約】

【課題】従来から用いられているガラス、石英、ステンレス、アルミナ、AINの焼結体は、フッ素系プラズマに対して十分な耐食性を示さず、焼結体においては、腐食が徐々に進行して焼結体の表面から結晶粒子の脱粒が生じ、パーティクルが発生するなどの問題があった。
【解決手段】CF、やSF、などのフッ素系腐食ガス或いはそのプラズマに曝される部位を、Y、La、Ce、Nd、Dyなどの周期律表3a族金属と、AI及び/又はSiを含む複合酸化物、例えば、3Y:O・・AI:O・、ダイシリケート、モノシリケートなどの焼結体などにより構成する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】フッ素系腐食ガス或いはぞのプラズマに曝 される部位が、周期律表3 a 族金属と、A!及び/又は Siを含む複合酸化物からなることを特徴とする耐食性 部材。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の風する技術分野】本発明は、特にフッ素系腐食 性ガスおよびフッ案系プラズマに対して高い耐食性を有 ズマプロセス装置の内の内壁材や治具等、放電管、メタ ルハライド等のランプ等の放電壁として使用される耐食 性部材に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】半導体製造のドライプロセスやプラズマ コーティング、放電管、ランプなど、プラズマの利用は 近年急速に進んでいる。半導体におけるプラズマプロセ スとしては、フッ案系等のハロゲン系腐食ガスがその反 応性の高さから、気相成長、エッチングやクリーニング に利用されている。

【0003】これら腐食性ガスに接触する部材には高い 耐食性が要求され、従来より被処理物以外のこれらプラ ズマに接触する部材は、一般にガラスや石英などのSi O:を主成分とする材料やステンレス、モネル等の耐食 件金属が多用されている。

【0004】また、半導体製造製造時において、ウェハ を支持固定するサセプタ材としてアルミナ焼結体、サフ ァイア、AINの焼結体、又はこれらをCVD法等によ ・り表面被覆したものが耐食性に優れるとして使用されて いる。また、グラファイト、窒化硼素をコーティングし 30 たヒータ等も使用されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来から用い られているガラスや石英ではプラズマ中の耐食性が不充 分で消耗が激しく、特にフッ素プラズマに接すると接触 面がエッチングされ、表面性状が変化したり、光透過性 が必要とされる部材では、表面が次第に白く曇って透光 性が低下する等の問題が生じていた。

【0006】また、ステンレスなどの金属を使用した部 材でも耐食性が不充分なため、脳食によって、特に半導 体製造においては不良品発生の原因となっていた。

【0007】アルミナ、AINの焼結体は、上記の材料 に比較してフッ素系ガスに対して耐食性に優れるもの の、高温でプラズマと接すると腐食が徐々に進行して焼 結体の表面から結晶粒子の脱粒が生じ、パーティグル発 生の原因になるという問題が起きている。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、フッ案系 腐食ガス及びプラズマに対する耐食性を高めるための方 法について検討を重ねた結果、まず、フッ案系紹食ガス 又はプラズマとの反応が進行すると高融点のフッ化物が 生成されること、特に周期律表第3a族元素とAlおよ び/またはSiとの複合酸化物は、安価に入手できると ともに、そのフッ化物が表面に安定なフッ化物層を形成 し部材の腐食性が抑制され、従来のアルミナやガラス、 AIN、Si, N. などよりも優れた耐食性を実現でき ることを知見したものである。

【0009】即ち、本発明の耐食性部材は、上配の知見 に基づき完成されたものであり、フッ素系腐食ガス或い する、ブラズマ処理装置や半導体製造用又は液晶用プラ 10 はそのプラズマに曝される耐食性部材における少なくと も前記腐食ガスやプラズマに直接接触する部位が、周期 律表第3a族元素と、Alおよび/またはSiを含む複 合酸化物によって構成することにより、高温、高密度の フッ芸系図食雰囲気において長時間の耐性を有する比較 的安価な部材を提供できるものである。

> 【0010】本発明によれば、フッ森系ガス及びプラズ マに曝される部材として周期律表第3a族元素と、Al 及び/又はSiを含む複合酸化物材料を使用することに より、材料表面がフッ素との反応によって安定なフッ化 物層を生成し、幅広い温度範囲で過酷なフッ案系腐食雰 **囲気への耐性向上が遠成される。さらに、フッ素と反応** して容易に揮発してしまうようなSi、Ge、Mo等の 元素化合物の粒界への析出を抑え、その通在を防ぐこと により、局部的な耐食性の低下とそれを原因とした脱粒 ・パーティクル発生を防止し、更なる耐食性の向上を図 ることが可能となる。これらの元素は腐食の初期段階で 揮発していくが、材料表面には第3a族を含むフッ化物 が残留して、次第に第3 a 族元素に富むフッ化物層が形 成される結果、腐食の進行を抑制することができる。

> 【0011】しかも、周期律表第3a族元素と、AI及 び/又はSiを含む複合酸化物は、周期律表第3a族元 素酸化物に比較して、PVD法、CVD法などの薄膜技 術によって形成するのに止まらず、緻密な焼結体として 作製することができるために、あらゆる形状品に適合す ることが可能となる。.

## - [0012]

50

【発明の実施の形態】本発明の耐食性部材は、フッ案系 の腐食ガスまたはフッ素系プラズマに曝される部材であ り、フッ素系ガスとしては、SF。、CF。、CH F.、CIF.、HF等が挙げられ、これらのガスが導 入された雰囲気にマイクロ波や高周波等を導入するとこ れらのガスがプラズマ化される。

【0013】本発明によれば、このようなフッ案系ガス あるいはそのプラズマに啜される部位を、少なくとも周 期律表第3a族元素と、Alおよび/またはSiとを含 む複合酸化物から構成するものである。ここで、複合酸 化物を構成する周期律表第3a族元素としては、Sc、 Y, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, H o、Er、Tm、Yb、Luなどいずれでの使用される が、特にY、La、Ce、Nd、Dyがコストの点で望

3

ましい.

[0014] この複合酸化物の耐食性は周期律扱第3a 族元素量に大きく影響され、周期律表第3a 族元素は、複合酸化物中の全金属元素中、30原子%以上、特に40原子%以上存在することが望ましい。これは、周期律表第3a 族元素量が30原子%より少ないと、ハロゲン化ガスやそのプラズマ中での初期の腐食が激しく次第に表面に保護層が形成されるものの、長時間を要するために実用的ではない。

【0015】また、複合酸化物としては、上配の少なくとも2種の金属元素を含むガラス、セラミック焼結体の他、単結晶であってもよいが、セラミック焼結体の場合には、粒界に折出した粒界相の耐食性が主結晶粒子より著しく劣る場合、粒界相が選択的に腐食され、脱粒、パーティクル発生の原因となる。そのため、フッ案に腐食されやすいSi、Ge、Mo、Wの粒界中の含有瓜は全型中1重量%以下に抑えることが好ましい。これらのフッ案に腐食されやすい元素が主結晶粒子内に固溶して粒界に存在しない場合はこの限りでない。

【0016】複合酸化物は、望ましくは、結晶質を主体 20 とすることがよく、特にYAG(3Y.O.・5A1:O.)などのガーネット型結晶、YAM(2Y.O.・A1:O.)などの単斜晶型結晶、YAP(Y.O.・A1:O.)などのペロブスカイト型結晶、モノシリケート(Y.O.・SiO.)、ダイシリケート(Y:O.・2SiO.)などのシリケート化合物を主体とするものが優れた耐食性を有する点で望ましい。これらの中でもガーネット型結晶、ダイシリケート型結晶が焼結性と関造コストが安価である点で最も望ましい。

【0017】また、上記複合酸化物の焼結体は、例えば、周期律表第3a族元素酸化物とAl. O: またはSiO: 粉末との混合物を1100~1900℃の酸化性雰囲気中又は真空雰囲気中で焼成することにより作製することができる。焼成方法としては、常圧焼成の他、ホットプレス法などが採用される。

【0018】また、本発明の耐食性部材としては、かかる焼結体にとどまらず、PVD法、CVD法などの周知の蒋腴形成法によって、所定の基体表面に薄膜として形成したものであってもよい。また、周知のゾルゲル法に

より液相を塗布し焼成した特膜でもよい。これらの中では、粉末を成形し焼成した焼結体であることが、あららいな部材への適用性に優れることから最も望ましいなお、この複合酸化物は、ハロゲン系腐食ガスまたはそのプラズマに曝される部位に形成されるものであるが、かかる金属酸化物は、少なくともその厚みが10μm以上であることが、優れた耐食性を付与する上で望ましい。つまり、その厚みが10μmより初いと優れた耐食効果が期待できないためである。

[0019]

実施例】各種酸化物粉末を用いて、表 $1 \sim$ 表3に配職の各種の材料を作製した。表1中、試料 $No.1 \sim 5$  は、表1の希土類酸化物とSiO: 及び/またはAI:0, との混合物を2000で溶融した後、急冷してガラス化したものである。試料No.6 < 7 はY:O, とSiO: を所定の割合で混合した成形体を $1300 \sim 1600$  ℃で焼成したものである。試料 $No.8 \sim 13$  は、Y:O: とAI:O, との混合物からなる成形体を $1600 \sim 1900$  の酸化性又は其空雰囲気で焼成したものである。試料No.14 < 15 は表1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000

【0020】そして、表1の種々の材料をRIEプラズマエッチング装置内に設置し、CF。とO:との混合ガス(CF。:O:=9:1)、ArとSF。との混合ガス(Ar:SF。=2:3)のいずれかを導入するとと30 もに、マイクロ波を導入してプラズマを発生させた。このプラズマ中で最高3時間保持して、処理前後の材料の重量減少を測定し、その値から1分あたりのエッチングされる厚み(エッチング速度)を算出した。また、した。【0021】なお、比較例として、従来のBN焼結体、石英ガラス、Si,N。焼結体、Al:O:焼結体、AlN焼結体についても同様に試験を行った。

[0022]

【表1】

ā						b
試料	材料	試料形態	驳起	エフチングレート (A/min)	表面状態	評価
<u>l</u>	V 0 5:0	ガラス	CF4÷02	52	強みあり	0
2	Y <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> · Si0 <sub>2</sub>		SF <sub>6</sub> ÷A=	68	密みあり	0
3	27z03 - SiO2	ガラス	CF4+02	30	住みあり	0
4	Nd203 · SiO2 · Al203	ガラス	CF4+02	. 47	組みあり	0
5	Dyz03 · SiOz · AlzO3	ガラス	CF4+02	45	塵みあり	0
6	Y203 SiO2	焼結体	CF4+0z	32	変化なし	0
7	27z03 · SiOz	焼結体	CF4+0z	28	変化なし	٥
8	7114 (TIE)	焼結体	CF4+02	14	変化なし	٥
9	YA10a (YAP)		SFa+Ar	20	変化なし	0
10		焼結体	CF4+02	18	変化なし	0
11	YaAlsOiz (YAG)		SF <sub>6</sub> +Ar	25	変化なし	٥
12		焼結体	CF4+02	10	変化なし	0
13	Y4Al2Og (YAM)		SF.+Ar	18	変化なし	0
14	Dy Alz09	焼結体	CF4+02	. 7	変化なし	. 🖨
15	EraAlaO1z	焼結体	CF4+0z	9	変化なし	٥
16	2Scz0a · 3Alz0a	מעק	CF4+02	11	変化なし	0
17	Lag03 · 2Alg0s	CVD	CF4+0z	13	変化なし	0
* 18	BN	焼結体	CF4+0z	46500	ぽろぽろ	×
* 19	石英 (SiO <sub>2</sub> )	ガラス	CF4+0z	1220	白く蓋る	×
<b>*</b> 20			SF <sub>6</sub> +Ar	890	白く最る	×
<b>*21</b>	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	焼結体	CF4+02	1730	粉状	×
*22	A1 0	烧結体	CF4+02	85	窪み多数	Δ
<b>* 23</b>	A1 <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub>		SF <sub>6</sub> +Ar	82	窪み多数	Δ
*24	AIN .	焼結体	CF4+0z	70	盤み多数	Δ
* 25	AIN .		SF4+Ar	71	窪み多数	Δ

\*甲は本発明の範囲外の試料を示す。

[0023] 表1に示すように、従来の各種材料は、いずれもエッチング速度が50 A/minを越えるものであり、しかも表面状態も荒れがひどく、Sin N・焼結体では、表面にパーティクルの発生が確認された。Al 30: O, やAl Nの焼結体もエッチングによる窪みが多数観察された。

【0024】これらの比較例に対して試料No.1~17の本発明の試料は、いずれもフッ素系プラズマに対して高い耐食性を示した。特に、試料形態がガラスからなるものは、その表面に短みの形成が確認されたが、焼結体や薄膜からなるものは、いずれも表面状態も優れたものであった。また、本発明のいずれの試料にも試験後にお

いて周期律表第3 a 族元素に富むフッ化物層が表面に形成されていることを確認した。

[00.2.5]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、フッ素系腐食性ガス及びそのプラズマに曝される部材として周期律表第3a族元素と、AI及び/又はSiとの複合酸化物により構成することで、少なくとも材料表面が安定なフッ化物層を生成し、過酷なフッ案系腐食雰囲気で高い耐食性が達成される。しかも焼結体を容易に作製できることから、あらゆる形状品に適用することができる。

フロントページの統き

(51) Int. Cl. 6

識別 記号

庁内整理番号

F I

技術安示箇所

21/3065

// C23C 16/50

CO4B 35/00

Н

H011 21/302

В